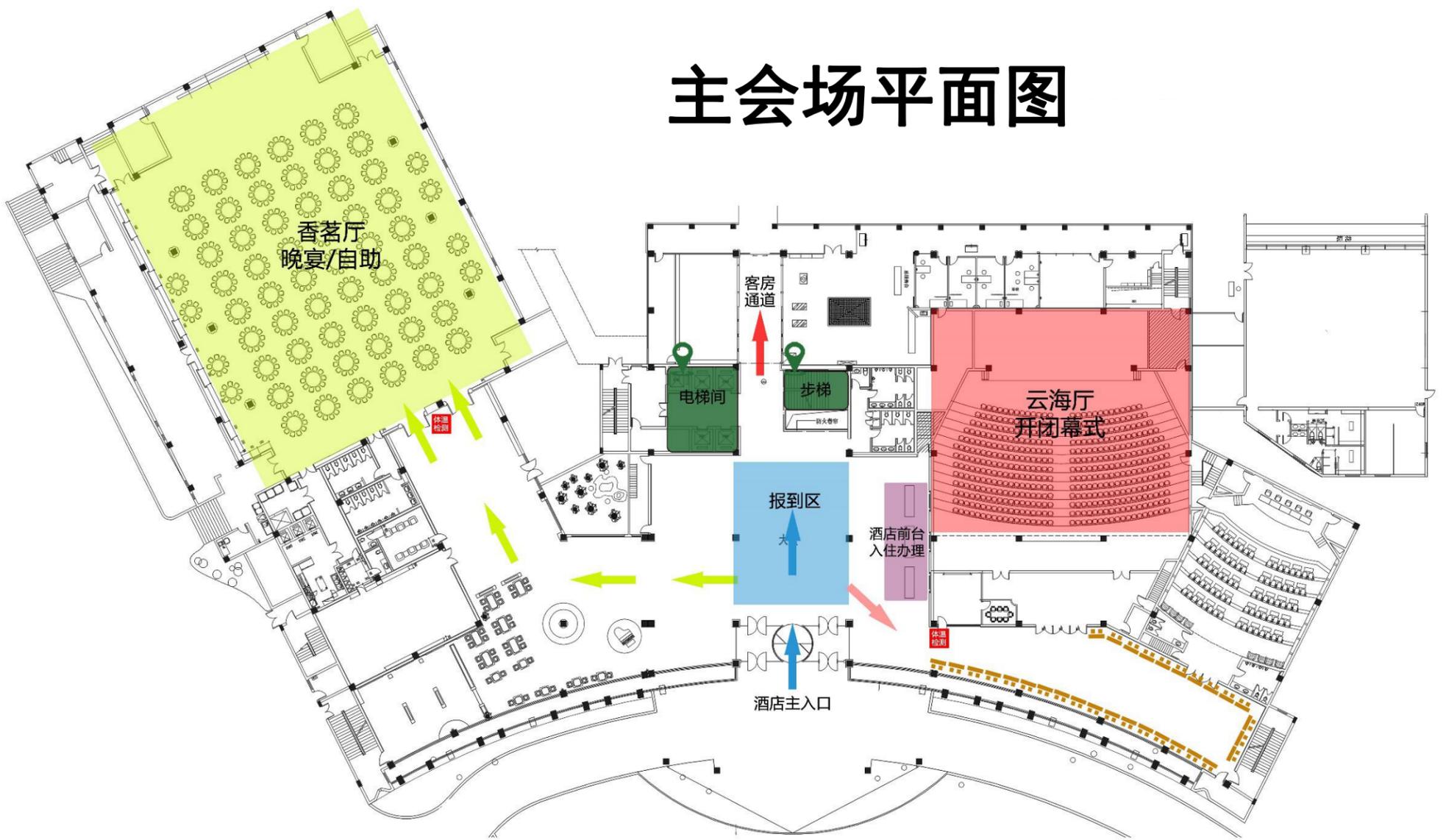


# 主会场平面图



# 分会场平面图

- A区、共计14个展位
- B区、共计16个展位



# 第十六届全国MOCVD学术会议

| 日期           | 时间          | 内容         | 地点   | 展示                         |
|--------------|-------------|------------|--|----------------------------|
| 8月4日<br>(周二) | 13:00-21:00 | 注册报到       | 香茗酒店一层大堂   | 展览展示<br>8月4日-8月6日<br>四层·长廊 |
|              | 18:00-20:00 | 自助晚餐       | 二层·香茗厅   |                            |
| 8月5日<br>(周三) | 08:30-09:00 | 开幕式、合影     | 二层·云海厅   |                            |
|              | 09:00-10:20 | 大会报告       | 二层·云海厅   |                            |
|              | 10:20-10:40 | 茶歇         |  |                            |
|              | 10:40-12:00 | 大会报告       | 二层·云海厅   |                            |
|              | 12:00-14:00 | 自助午餐       | 二层·香茗厅   |                            |
|              | 14:00-15:40 | 分会报告       | A) 四层·会议室8    B) 四层·新安江厅<br>C) 四层·会议室2    D) 四层·会议室7 |                            |
|              | 15:40-16:00 | 茶歇         |  |                            |
|              | 15:55-17:50 | 分会报告       | A) 四层·会议室8    B) 四层·新安江厅<br>C) 四层·会议室2    D) 四层·会议室7 |                            |
|              | 18:00-20:00 | 自助晚餐       | 二层·香茗厅   |                            |
|              | 19:00-21:00 | Poster展示交流 | 四层·长廊  |                            |
| 8月6日<br>(周四) | 08:30-10:10 | 分会报告       | A) 四层·会议室8    B) 四层·新安江厅<br>C) 四层·会议室2    D) 四层·会议室7 |                            |
|              | 10:10-10:30 | 茶歇         |  |                            |
|              | 10:30-12:10 | 分会报告       | A) 四层·会议室8    B) 四层·新安江厅<br>C) 四层·会议室2    D) 四层·会议室7 |                            |
|              | 12:10-14:00 | 自助午餐       | 二层·香茗厅   |                            |
|              | 14:00-15:10 | 大会报告       | 二层·云海厅   |                            |
|              | 15:10-15:30 | 茶歇         |  |                            |
|              | 15:30-16:35 | 大会报告       | 二层·云海厅   |                            |
|              | 16:35-17:50 | 闭幕式        | 二层·云海厅   |                            |
| 18:00-21:00  | 晚宴          | 二层·香茗厅     |  |                            |
| 8月7日<br>(周五) | 参观考察及返程     |            |  |                            |

8月5日（星期三）

8:30  
|  
9:00

开幕式、合影

大会报告

9:00  
|  
9:40

从半导体科技谈国家创新体系  
郝 跃  
西安电子科技大学

9:40  
|  
10:20

纯LED照明进展  
江风益  
南昌大学

10:20  
|  
10:40

茶歇

10:40  
|  
11:20

疫情下的半导体深紫外LED技术与发展趋势  
李晋闽  
中国科学院半导体研究所

11:20  
|  
12:00

超宽禁带半导体氧化镓的外延生长  
张 荣  
厦门大学/南京大学

报告时间35分钟，问答时间5分钟

# 8月5日（星期三）

## 午餐

12:10-14:00

| 分会报告 | 材料生长及物性表征<br>A(一) | 光电子材料与器件<br>B(一)B | 功率电子与射频电子器件<br>C(一)C | 新兴半导体材料及应用<br>D(一) |
|------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
|------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|

| 主持人 | 汪莱 | 魏同波 | 陆海 | 单崇新 |
|-----|----|-----|----|-----|
|-----|----|-----|----|-----|

|                     |   |  |  |  |
|---------------------|---|--|--|--|
| 14:00<br> <br>14:20 | IA1(邀请报告):<br>蓝宝石衬底上GaN基共振隧穿二极管研究<br>王丁, 陈兆营, 王涛, 杨流云, 张宝庆, 苏娟, 谭为, 郭世平, 王新强<br>北京大学<br>清华大学<br>中微半导体设备(上海)股份有限公司 | IB1(邀请报告):<br>氮极性GaN薄膜的外延生长研究<br>张源涛, 邓高强, 余焯, 刘放, 王新强<br>吉林大学<br>北京大学 | IC1(邀请报告):<br>用于微波无线传能和大功率检波的近理想GaN二极管研究<br>张进成, 张涛, 党魁, 张燕妮, 周弘, 郝跃<br>西安电子科技大学 | ID1(邀请报告):<br>超宽禁带氧化镓半导体器件发展态势和机遇<br>龙世兵<br>中国科学技术大学 |
|---------------------|---|--|--|--|

|                     |   |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|---|
| 14:20<br> <br>14:40 | IA2(邀请报告):<br>高质量超薄AlGaIn/GaN HEMT外延技术研究<br>李忠辉, 张东国, 彭大青, 杨乾坤, 李传皓, 罗伟科, 董逊<br>南京电子器件研究所 | IB2(邀请报告):<br>氮化物/蓝宝石界面构型及原子级堆叠过程及氮化物范德华外延<br>刘志强, 梁萌, 伊晓燕, 王军喜, 李晋闽<br>中国科学院半导体研究所 | IC2(邀请报告):<br>MOCVD选区掺杂氮化物及毫米波器件<br>张韵, 张连, 程哲, 何亚伟, 高幸发<br>中国科学院半导体研究所, 中国科学院大学材料科学与光电技术学院 | ID2(邀请报告):<br>$\beta$ -Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 单晶衬底材料新进展<br>郝建民<br>中国电子科技集团公司第四十六研究所 |
|---------------------|---|---|---|---|

|                     |   |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|---|
| 14:40<br> <br>14:55 | OA1(口头报告):<br>高质量可转移GaInN薄膜的扩散-吸附调制生长<br>贾彦青, 宁静, 张进成, 郝跃<br>西安电子科技大学 | OB1(口头报告):<br>短波红外砷磷化合物光电材料研究<br>贡溢, 王红真, 朱莎露, 陈平平, 马英杰, 张永刚, 李雪, 龚海梅<br>中国科学院上海技术物理研究所<br>中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | OC1(口头报告):<br>具有强雪崩泄放能力的650V/8A准垂直GaInN肖特基二极管研究<br>周峰, 徐尉宗, 任芳芳, 陈敦军, 张荣, 郑有焯, 陆海<br>南京大学 | OD1(口头报告):<br>Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 薄膜的高温MOCVD外延、掺杂与探测器制备<br>董鑫, 李曠明, 焦腾, 张源涛, 张宝林<br>吉林大学 |
|---------------------|---|---|---|---|

|                     |  |  |  |   |
|---------------------|--|--|--|---|
| 14:55<br> <br>15:10 | OA2(口头报告):<br>利用掺杂突变提高GaInN基垂直腔面发射激光器的电流扩展效应<br>张勇辉, 邱雪皎, 张紫辉, 田康凯, 车佳滢, 邵华, 常乐, 刘亚津, 张际, 张丹扬, 贾兴宇<br>河北工业大学 | OB2(口头报告):<br>面向Micro-LED应用的InGaInN基高效橙红光LED研究<br>张胜男, 张建立, 王小兰, 郑畅达, 高江东, 吴小明, 徐龙权, 丁杰, 江风益<br>南昌大学 | OC2(口头报告):<br>基于Ar离子注入终端的准垂直硅基GaInN SBD及漏电机制研究<br>郭小路, 钟耀宗, 周宇, 苏帅, 陈昕, 刘建勋, 高宏伟, 孙钱, 杨辉<br>中国科学技术大学纳米技术与纳米仿生学院, 中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | OD2(口头报告):<br>基于雾化化学气相沉积法异质外延生长单晶 $\beta$ -Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 薄膜<br>许育, 张春福, 成邀林, 李哲, 冯倩, 张进成, 郝跃<br>西安电子科技大学 |
|---------------------|--|--|--|---|

|                     |  |  |   |  |
|---------------------|--|--|---|--|
| 15:10<br> <br>15:25 | OA3(口头报告):<br>200 mm硅晶圆上外延生长的In <sub>x</sub> Ga <sub>1-x</sub> As/GaAs超晶格位错过滤层的有效性研究<br>王冰<br>中山大学 | OB3(口头报告):<br>无荧光粉多基色白光LED空间颜色均匀性研究<br>朱昕, 郭醒, 罗昕, 徐龙权, 张建立, 江风益<br>南昌大学 | OC3(口头报告):<br>一种基于快速肖特基刻蚀及场板电场调控的3.4 kV AlGaInN/GaN硅基肖特基二极管<br>徐儒, 陈鹏, 刘梦涵, 李一萌, 周婧, 刘斌, 谢自力, 张荣, 郑有焯<br>南京大学 | OD3(口头报告):<br>$\beta$ -氧化镓薄膜的微结构研究<br>李悦文, 修向前, 张丽颖, 华雪梅, 谢自力, 陈鹏, 刘斌, 张荣, 郑有焯<br>南京大学 |
|---------------------|--|--|---|--|

|                     |  |  |   |  |
|---------------------|--|--|---|--|
| 15:25<br> <br>15:40 | OA4(口头报告):<br>GaInN离子注入p型掺杂技术<br>石娅婷, 徐尉宗, 陈选虎, 任芳芳, 周东, 叶建东, 陈敦军, 张荣, 郑有焯, 陆海<br>南京大学 | OB4(口头报告):<br>基于三维结构的高显指白光LED器件<br>赵捷, 魏同波, 王军喜, 李晋闽<br>中国科学院半导体研究所<br>中国科学院大学 | OC4(口头报告):<br>用于获得高击穿电压和低漏电流的Mesa型GaInN基肖特基势垒二极管的设计策略<br>田康凯, 贾兴宇, 张紫辉, 刘亚津, 车佳滢, 邵华, 常乐, 邱雪皎, 张际, 张丹扬, 张勇辉<br>河北工业大学 | OD4(口头报告):<br>利用MOCVD制备高质量的Si掺杂氧化镓同质外延薄膜<br>季学强, 岳建英, 陈旭, 陈政委, 唐为华<br>北京镓族科技有限公司<br>北京邮电大学 |
|---------------------|--|--|---|--|

邀请报告17分钟+3分钟问答, 口头报告12分钟+3分钟问答

# 8月5日（星期三）

## 茶歇

15:40-15:55

### 分会报告

材料生长及物性表征  
A(二)

光电子材料与器件  
B(二)

功率电子与射频电子器件  
C(二)

新兴半导体材料及应用  
D(二)

### 主持人

李忠辉

戴江南

张进成

龙世兵

15:55

16:15

IA3(邀请报告):  
**GaN单晶材料的掺杂与电学特性调控**  
王建峰, 张育民, 蔡德敏, 徐俞, 王明月, 胡晓剑, 徐科  
中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所  
苏州纳维科技有限公司

IB3(邀请报告):  
**半导体仿真技术在第三代半导体器件中的应用**  
张紫辉, 张勇辉, 田康凯, 楚春双, 车佳滢, 邵华, 寇建权, 贾兴宇, 张际, 高元斌, 杭升, 邱雪娇, 常乐, 刘亚津, 张丹扬  
河北工业大学

IC3(邀请报告):  
**硅基GaN电子器件及材料研究进展**  
孙钱  
中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所

ID3(邀请报告):  
**金刚石超宽禁带半导体材料与器件研究**  
单崇新, 林超男, 杨珣, 杨西贵  
郑州大学

16:15

16:35

IA4(邀请报告):  
**宽禁带半导体自旋和谷电子学性质研究**  
唐宁, 刘星辰, 张晓玥, 张仕雄, 葛惟昆, 沈波  
北京大学

IB4(邀请报告):  
**Analysis of TM/TE mode enhancement and droop reduction by a nanoporous n-AlGaN underlayer in a 290 nm UV-LED**  
李虞锋, 王辰雨, 张焯, 胡鹏, 张胜楠, 苏喜林, 杜梦琦, 李强, 云峰  
西安交通大学

IC4(邀请报告):  
**超薄势垒AlGaN/GaN异质结构功率器件与集成研究**  
黄森, 王鑫华, 魏珂, 刘新宇  
中国科学院微电子研究所  
中国科学院大学

ID4(邀请报告):  
**超宽禁带氧化镓功率器件技术进展与展望**  
吕元杰, 王元刚, 刘宏宇, 敦少博, 梁士雄, 冯志红, 蔡树军  
中国电子科技集团公司第十三研究所

16:35

16:50

IA5(邀请报告):  
**真空紫外光电子材料与器件**  
郑伟  
中山大学

OB5(口头报告):  
**氮极性III族氮化物隧穿结LED制备研究**  
邓高强, 余焯, 王阳, 张源涛  
吉林大学

OC5(口头报告):  
**基于p型栅二次外延的GaN基增强型HEMT栅极可靠性**  
钟耀宗, 苏帅, 周宇, 陈昕, 高宏伟, 詹晓宁, 郭小路, 孙钱, 杨辉  
苏州纳米技术与纳米仿生研究所

ID5(邀请报告):  
**氧化镓半导体材料外延与日盲探测器件应用**  
叶建东, 顾书林, 张荣, 郑有焯  
南京大学

16:50

17:05

OA5(口头报告):  
**Dynamics of localized excitons in monolayer GaN/AlN quantum wells**  
Maocheng Shan, Yi Zhang, Changqing Chen, Xiaohang Li  
Huazhong University of Science and Technology  
King Abdullah University of Science and Technology (KAUST)

OB6(口头报告):  
**电注入绿光GaN微腔中的三维限制光子态**  
梅洋, 陈衍晖, 徐欢, 许荣彬, 郑志威, 龙浩, 应磊莹, 张保平  
厦门大学

OC6(口头报告):  
**Temperature-Dependent Dynamic  $R_{ON}$  of GaN HEMT under Hard-Switching**  
Shaocheng Li, Shu Yang, and Kuang Sheng  
Zhejiang University

OD5(口头报告):  
**MOCVD外延生长Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/GaN异质结及其日盲紫外探测器应用**  
林日成, 郑伟, 张丹, 黄丰  
中山大学

17:05

17:20

OA6(口头报告):  
**室温下通过极化电场有效调控InGaN/GaN量子阱的自旋弛豫时间**  
刘星辰, 唐宁, 张仕雄, 张晓玥, 管鸿明, 张云帆, 钱轩, 姬扬, 葛惟昆, 沈波  
北京大学  
中国科学院半导体所半导体超晶格国家重点实验室

OB7(口头报告):  
**大功率GaN基蓝光超辐射发光二极管**  
熊巍, 胡磊, 刘建平, 杨辉  
中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所  
中国科学技术大学

OC7(口头报告):  
**GaN HEMT器件高频可靠性研究及高频开关电源应用**  
雷建明, 郭慧, 王蕊, 陈敦军, 陆海, 张荣, 郑有焯  
南京大学, 南京工业职业技术大学

OD6(口头报告):  
**高质量亚稳相 $\alpha$ -In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>异质外延及其生长机理研究**  
况悦, 马同川, 陈选虎, 叶建东, 顾书林, 张荣, 郑有焯  
南京大学

17:20

17:35

OA7(口头报告):  
**基于晶面变化的GaN/AlN量子结构能带调控**  
闫金健, 董悦, 林伟, 康俊勇  
厦门大学

OB8(口头报告):  
**垂直外腔面发射激光器的材料生长及器件验证**  
李健, 汪超, 李川川, 韦欣  
中国科学院半导体研究所

OC8(口头报告):  
**Threshold voltage shift in AlN/Al<sub>0.05</sub>Ga<sub>0.95</sub>N HEMTs on Si substrate by surface states adjustment**  
Xi Liu, Weihang Zhang, Liyu Fu, Jincheng Zhang, Yue Hao  
Xidian University

OD7(口头报告):  
**辉光放电光谱仪在镀层结构中的应用**  
武艳红, 许鹏  
堀场(中国)贸易有限公司

17:35

17:50

OA8(口头报告):  
**高温热处理PVD AlN层中孔洞产生机理**  
贲建伟, 石芝铭, 臧行, 孙晓娟, 吕威, 黎大兵  
中国科学院长春光学精密机械与物理研究所  
中国科学院大学  
长春工业大学

OB9(口头报告):  
**基于半极性GaN与量子点光刻胶的Micro-LED全彩显示器件**  
吴挺竹, 黄陈嵩文, 陈忠, 林岳, 郭浩中  
厦门大学  
台湾交通大学

OC9(口头报告):  
**基于氧氟复合等离子体处理工艺的增强型AlGaN/GaN HEMT功率器件阈值电压稳定性研究**  
孙楠, 王荣华, 黄火林, 孙仲豪, 赵程, 宋书宽, 任永硕  
大连理工大学  
大连芯冠科技有限公司

OD8(口头报告):  
**基于新型增益机制的石墨烯异质结紫外光电探测器的研究**  
任显松, 郭霞  
北京邮电大学

19:00-21:00

## 海报展示与交流(P-1~P-127)

# 8月6日（星期四）

| 分会报告               | 材料生长及物性表征<br>A(三)  | 光电子材料与器件<br>B(三)  | 功率电子与射频电子器件<br>C(三)  | 新兴半导体材料及应用<br>D(三)  |
|--------------------|--|---|--|---|
| 主持人                | 唐宁   | 张源涛   | 冯志红  | 王科  |
| 8:30<br> <br>8:50  | IA6(邀请报告):<br><b>Al(Ga)N材料的应变和缺陷调控</b><br>冻志涛, 何晨光, 赵维, 刘宁炆,<br>吴华龙, 张康, 贺龙飞<br>广东省科学院,<br>广东省半导体产业技术研究院   | IB5(邀请报告):<br><b>深紫外发光器件外延生长的研究进展</b><br>戴江南, 张毅, 梁仁璠,<br>单茂诚, 郑志华, 陈长清<br>华中科技大学<br>鄂州工研院技术研究院<br>湖北深紫科技有限公司           | IC5(邀请报告):<br><b>GaN新器件技术及应用</b><br>孔月婵, 张凯, 吴立枢,<br>陈堂胜<br>南京电子器件研究所  | ID6(邀请报告):<br><b>局域极化场调控的新型光电器件</b><br>王建禄<br>中科院上海技术物理研究所  |
| 8:50<br> <br>9:10  | IA7(邀请报告):<br><b>AlGaIn基深紫外LED材料和器件研究</b><br>许福军, 沈波<br>北京大学   | IB6(邀请报告):<br><b>应用于深紫外LED的MoO<sub>x</sub>/Al和Ni/Al高反射率p型电极</b><br>郭炜, 李亮, 叶继春<br>中国科学院宁波材料技术与工程研究所                     | IC6(邀请报告):<br><b>面向氮化镓电力电子器件产业化的可靠性评价</b><br>王荣华, 任永硕, 程万希,<br>黄火林, 梁辉南<br>大连芯冠科技有限公司<br>大连理工大学  | ID7(邀请报告):<br><b>基于纳米图形模板的AlGaIn横向外延与紫外雪崩光电探测器</b><br>陈敦军, 蔡青, 游海帆, 汪金,<br>陆海, 张荣, 郑有焯<br>南京大学  |
| 9:10<br> <br>9:30  | IA8(邀请报告):<br><b>AlN基材料制备、缺陷演变及紫外探测器研究</b><br>孙晓娟, 蒋科, 贲建伟, 张山丽,<br>开翠红, 吴忱, 臧行, 黎大兵<br>中国科学院长春光学精密机械与物理研究所<br>中国科学院大学   | OB10(口头报告):<br><b>室温下半导体微腔激子polariton相干凝聚特性研究</b><br>朱海, 陈智阳, 郑湖颖,<br>汤梓荧<br>中山大学                                       | OC10(口头报告):<br><b>Direct Evidence of Hydrogen Interaction with Carbon: C-H complex in Semi-insulating GaN</b><br>Shan Wu, Xuelin Yang, Weikun Ge,<br>and Bo Shen<br>School of Microelectronics, USTC | OD9(口头报告):<br><b>极宽禁带半导体AlN的紫外光学超表面微结构和器件研究进展</b><br>汪炼成, 胡泽林, 高祥, 李滔,<br>龙林云, 闫建昌<br>中南大学<br>中国科学院半导体研究所   |
| 9:30<br> <br>9:45  | OA9(口头报告):<br><b>AlGaIn基深紫外LED的p型GaIn接触层选区生长研究</b><br>郭亚楠, 闫建昌, 张韵, 孙莉莉,<br>曾一平, 李晋闽, 王军喜<br>中国科学院半导体研究所<br>中国科学院大学<br>北京中科优唯科技有限公司  | OB11(口头报告):<br><b>金属有机源(MO源)的技术发展</b><br>俞冬雷, 徐昕, 王伟<br>安徽亚格盛电子新材料有限公司  | OC11(口头报告):<br><b>优化缓冲层的生长条件以提高硅基GaN功率器件的击穿电压</b><br>陈耀, 康双双, 胡建正, 闫龙,<br>周宁, 王文, 郭世平<br>中微半导体设备(上海)股份有限公司   | OD10(口头报告):<br><b>Metal-Semiconductor-Metal <math>\epsilon</math>-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Solar-Blind Photodetectors with a Record-High Responsivity Rejection Ratio</b><br>Yuan Qin, Liheng Li, Xiaolong Zhao, Haiding Sun, Kanhao Xue, Shibing Long, Ming Liu<br>University of Science and Technology of China<br>Huazhong University of Science and Technology                                     |
| 9:40<br> <br>9:55  | OA10(口头报告):<br><b>Epitaxial Manufacturing Solutions for Compound Semiconductors</b><br>Ziwen Fang, Jens Voigt,<br>Thomas Korst, Martin Eickelkamp<br>Assadullah Alam, Adam R. Boyd,<br>Michael Heuken.<br>AIXTRON SE | OB12(口头报告):<br><b>MOCVD生长GaInP/GaInAsP 780-880nm大功率半导体激光器</b><br>朱振, 苏建, 孙素娟, 郑兆河,<br>王成新, 徐现刚<br>山东华光光电子股份有限公司<br>山东大学 | OC12(口头报告):<br><b>GaN基p-i-n二极管雪崩击穿退化机制与新型终端结构研究</b><br>柏宇, 徐尉宗, 任芳芳, 周东,<br>陈敦军, 张荣, 郑有焯, 陆海<br>南京大学   | OD11(口头报告):<br><b>基于SiC厚膜的p-i-n型X射线与<math>\alpha</math>粒子探测器</b><br>刘清, 徐尉宗, 张衡, 张荣,<br>郑有焯, 陆海<br>南京大学   |
| 9:55<br> <br>10:10 | OA11(口头报告):<br><b>高Al组分硅基AlGaIn异质外延生长研究</b><br>黄应南, 刘建勋, 高宏伟,<br>孙秀建, 詹晓宁, 孙钱, 杨辉<br>中国科学技术大学纳米技术与纳米仿生学院<br>中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所  | OB13(口头报告):<br><b>基于GaN基WGM-FP混合腔体激光器设计与研究</b><br>谢明远, 王永进, 施政<br>南京邮电大学  | OC13(口头报告):<br><b>基于原位SiNx的薄势垒AlGaIn/GaN异质结电学特性研究</b><br>何佳琦, 蒋洋, 范梦雅, 汪青,<br>于洪宇<br>南方科技大学  | OD12(口头报告):<br><b>Enhance the stability of AlGaIn/GaN-HEMTs pH sensor by reference device</b><br>Yan Dong, Beilei Ren, Zhijie Deng,<br>Yanli Liu, Rui Wang, Jianming Lei,<br>Quan Dai, Jeong-Gil Kim, Seung-Hyeon Kang, Chul-Ho Won,<br>Dunjun Chen, Jung-Hee Lee, Hai Lu, Rong Zhang, Youdou Zheng<br>Nanjing University<br>Kyungpook National University<br>Shandong Technology and Business University |

邀请报告17分钟+3分钟问答, 口头报告12分钟+3分钟问答

# 8月6日（星期四）

## 茶歇

| 10:10-10:30         | 茶歇   |   |   |   |
|---------------------|--|---|---|---|
| 分会报告                | 材料生长及物性表征<br>A(四)  | 光电子材料与器件<br>B(四)  | 功率电子与射频电子器件<br>C(四)   | 新兴半导体材料及应用<br>D(四)  |
| 主持人                 | 叶建东  | 陈鹏  | 王茂俊   | 陈敦军   |
| 10:30<br> <br>10:50 | IA9(邀请报告):<br><b>InGaN/GaN量子点Micro-LED</b><br><br>汪莱, 王磊, 郝智彪, 罗毅<br>清华大学                              | IB7(邀请报告):<br><b>准范德华外延AlN及<br/>深紫外LED器件研究</b><br><br>魏同波, 常洪亮, 梁冬冬,<br>闫建昌, 王军喜, 刘忠范,<br>李晋闽<br>中国科学院半导体研究所<br>北京大学        | IC7(邀请报告):<br><b>金刚石微波功率器件进展</b><br><br>冯志红, 蔚翠, 周闯杰,<br>郭建超, 何泽召, 宋旭波<br>中国电子科技集团公司第十三研究<br>所  | ID8(邀请报告):<br><b>高Al组分AlGaIn反常量子限域<br/>机制及其调控方法</b><br><br>陈荔, 郭炜, 林伟, 康俊勇,<br>叶继春<br>中国科学院宁波材料技术与工<br>程研究所<br>厦门大学   |
| 10:50<br> <br>11:10 | IA10(邀请报告):<br><b>纳米结构深紫外LED外<br/>延与新型器件</b><br><br>闫建昌, 张亮, 郭亚楠,<br>李晋闽, 王军喜<br>中国科学院半导体研究所           | IB8(邀请报告):<br><b>利用衬底大斜切角和新型量<br/>子结构设计提高深紫外LED<br/>发光效率</b><br><br>孙海定<br>中国科学技术大学   | IC8(邀请报告):<br><b>新型碳化硅电力电子器件<br/>探索研究</b><br><br>郭清<br>浙江大学   | ID9(邀请报告):<br><b>石墨烯/氮化物界面诱导高灵<br/>敏光电探测器及其增益机制<br/>研究</b><br><br>胡安琪, 郭霞<br>北京邮电大学   |
| 11:10<br> <br>11:30 | IA11(邀请报告):<br><b>氮化镓中的碳杂质及<br/>相关点缺陷研究</b><br><br>杨学林, 张洁, 魏来, 冯玉霞,<br>沈波<br>北京大学                     | OB14(口头报告):<br><b>集成偏振的超像元结构<br/>InGaAs焦平面探测器研制</b><br><br>孙夺, 李雪, 杨波, 李淘,<br>杨力怡, 王世勇, 尹佳琪<br>中国科学院上海技术物理研究所               | IC9(邀请报告):<br><b>微悬臂AlGaIn/GaN HEMT和<br/>仿神经控制系统</b><br><br>胡卫国<br>中国科学院北京纳米能源与系统研<br>究所  | ID10(邀请报告):<br><b>MBE生长氮化物半导体<br/>材料及深紫外LED</b><br><br>王科, 李振华, 施根俊, 邵鹏飞,<br>吴耀政, 陶涛, 谢自力, 刘斌,<br>张荣, 郑有焯, N. Maeda, M.<br>A. Khan, H. Hirayama<br>南京大学,<br>厦门大学,<br>日本国立理化学研究所 (RIKEN) |
| 11:30<br> <br>11:45 | OA12(口头报告):<br><b>非极性AlGaIn基深紫外量子阱<br/>光学性质的研究</b><br><br>赵见国, 刘斌, 张雄, 常建华<br>南京大学<br>南京信息工程大学<br>东南大学 | OB15(口头报告):<br><b>极化调制多量子垒EBL对<br/>AlGaIn基深紫外LED载流子输<br/>运性质的影响研究</b><br><br>郭婧, 许福军, 葛惟昆, 刘百银,<br>张娜, 孙元浩, 王嘉铭, 沈波<br>北京大学 | OC14(口头报告):<br><b>铁电电荷存储栅叠层结构的<br/>增强型Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>基MOSFET</b><br><br>蔡云匆, 封兆青, 冯倩,<br>张进成, 郝跃<br>西安电子科技大学                              | OD13(口头报告):<br><b>石墨烯上生长高质量GaIn厚膜<br/>及其自支撑衬底应用</b><br><br>徐俞, 曹冰, 郑树楠, 蔡德敏,<br>王明月, 张育民, 王建峰,<br>徐科<br>中国科学院苏州纳米技术与纳<br>米仿生研究所<br>苏州纳维科技有限公司<br>苏州大学                                   |
| 11:45<br> <br>12:00 | OA13(口头报告):<br><b>柔性GaIn基HEMT的制备及<br/>性能调控研究</b><br><br>陈鑫, 董建奇, 王幸福<br>华南师范大学                         | OB16(口头报告):<br><b>基于全空间全向反射镜的深<br/>紫外发光二极管光学特性研<br/>究</b><br><br>张爽, 刘源, 张骏, 张毅,<br>许琳琳, 吴峰, 戴江南, 陈长清<br>华中科技大学             | OC15(口头报告):<br><b>基于场板结构的β相氧化镓<br/>肖特基二极管</b><br><br>菅光忠, 何启鸣, 董航, 覃愿, 张<br>颖, 徐光伟, 龙世兵, 刘明<br>中国科学院微电子研究所  | OD14(邀请报告):<br><b>大尺寸MOCVD基座盘的<br/>制备与国产化</b><br><br>汪洋, 万强<br>湖南德智新材料有限公司<br>南京工业大学  |
| 12:00<br> <br>12:15 | OA14(口头报告):<br><b>高质量柔性氮化镓外延薄膜<br/>的生长</b><br><br>宁静, 闫朝超, 贾彦青,<br>王博宇, 王东, 张进成, 郝跃<br>西安电子科技大学        | OB17(口头报告):<br><b>高性能斜台面AlGaIn紫外雪崩<br/>光电探测器</b><br><br>许海帆, 王海萍, 陈敦军, 张荣,<br>郑有焯<br>南京大学                                   | OC16(口头报告):<br><b>氢终端金刚石MOSFET与<br/>AlGaIn/GaN HEMT直流特性与大信<br/>号特性对比</b><br><br>崔傲, 王东, 张金凤, 吴勇, 陈兴,<br>任泽阳, 陈军飞, 袁珂, 操焰<br>西安电子科技大学芜湖研究院<br>西安电子科技大学 | OD15(口头报告):<br><b>NiO/β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> II型<br/>异质结研究</b><br><br>巩贺贺, 徐阳, 陈选虎,<br>郝景刚, 叶建东, 顾书林,<br>张荣, 郑有焯<br>南京大学   |

邀请报告17分钟+3分钟问答，口头报告12分钟+3分钟问答

8月6日（星期四）

12:10

|  
14:00

午餐

大会报告

14:00

|  
14:40

Si上GaN大失配异质外延中的缺陷工程

沈波  
北京大学

14:40

|  
15:20

基于MOCVD生长的铋化物超晶格红外探测器

杨辉  
中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所

15:20

|  
16:00

III-V族化合物半导体光电子材料与器件进展

徐现刚  
山东大学

16:00

|  
16:15

茶歇

嘉宾论坛 Panel discussion

16:15

|  
17:00

主题：

(1) 面向短波长、长波长、微型化光电子器件，MOCVD设备与外延生长技术发展趋势。

(2) 宽禁带半导体SiC、GaN基功率电子器件如何提升性价比？超宽禁带半导体器件如何推进实用化？

17:00

|  
17:30

闭幕式

18:00

|  
20:00

晚宴

8月7日（星期五）参观考察